

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【公開番号】特開2006-100810(P2006-100810A)

【公開日】平成18年4月13日(2006.4.13)

【年通号数】公開・登録公報2006-015

【出願番号】特願2005-249781(P2005-249781)

【国際特許分類】

H 01 L 21/336 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

H 01 L 21/20 (2006.01)

H 01 L 21/268 (2006.01)

H 01 L 21/308 (2006.01)

H 01 L 21/3065 (2006.01)

H 01 L 21/316 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/78 6 2 7 C

H 01 L 21/20

H 01 L 21/268 F

H 01 L 21/308 D

H 01 L 21/302 1 0 5 A

H 01 L 21/316 S

【手続補正書】

【提出日】平成20年8月5日(2008.8.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体膜上に形成された第1の酸化物層の一部にレーザ光を照射して、前記第1の酸化物層の一部を第2の酸化物層に変質させた後、前記第1の酸化物層の露出部を除去し、

前記第2の酸化物層をマスクとして前記半導体膜をエッチングして、半導体領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項2】

請求項1において、

前記レーザ光は、レーザビーム描画装置から射出される光であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、

前記半導体領域は、非晶質であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項4】

請求項1または請求項2において、

前記半導体領域は、結晶質であることを特徴とする半導体装置の作製方法。